

Pressmeddelande

KIOXIA levererar provexemplar av UFS ver. 4.1 inbäddade flashminnesenheter

Nya UFS-enheter med KIOXIAs 8:e generationens BiCS FLASH^{TM(1)} ökar hastigheten och strömeffektiviteten



Düsseldorf, Tyskland, 9 juli 2025 – [KIOXIA Europe GmbH](#) meddelade idag att företaget har börjat leverera provexemplar av sina Universal Flash Storage⁽²⁾ (UFS) ver. 4.1 inbyggda minnesenheter, vilket förstärker företagets ledande ställning inom högpresterande lagring. De nya enheterna är konstruerade för att möta kraven från nästa generations mobila applikationer, inklusive avancerade smarttelefoner med inbyggd AI, och erbjuder bättre prestanda med högre strömeffektivitet⁽³⁾ i ett litet BGA-paket.

UFS ver. 4.1-enheterna från KIOXIA integrerar företagets innovativa BiCS FLASHTM 3D-flashminne och en styrenhet i ett JEDEC[®]-standardpaket. Dessa nya UFS-enheter är byggda med KIOXIAs 8:e generationens BiCS FLASHTM 3D flashminne⁽¹⁾.

I den här generationen introduceras CBA-teknik (CMOS directly Bonded to Array) – en arkitektonisk innovation som innebär ett stort steg framåt inom flashminnesdesign. Genom att direkt binda CMOS-kretsarna till minnesmatrisen möjliggör CBA-tekniken stora vinster i energieffektivitet, prestanda och densitet.

Med en kombination av hög hastighet och låg energiförbrukning är KIOXIAs UFS ver. 4.1-enheter byggda för att förbättra användarupplevelsen – med snabbare nedladdningar och smidigare app-prestanda.

Viktiga funktioner inkluderar:

- Finns i kapaciteter på 256 och 512 gigabyte (GB) samt 1 terabyte (TB).
- Prestandaförbättring jämfört med föregående generation⁽³⁾:
 - Slumpmässig skrivning: 512 GB/1 TB ca +30 %
 - Slumpmässig läsning: 512 GB ca +45 %, 1 TB ca +35 %
 -
- Bättre strömeffektivitet jämfört med föregående generation⁽³⁾:
 - Läsning: 512 GB/1 TB förbättring på ca +15 %
 - Skrivning: 512 GB/1 TB förbättring på ca +20 %
- Host Initiated Defragmentation möjliggör fördröjd skräppuppsamling för oavbruten snabb prestanda under kritiska perioder
- WriteBooster-buffertstorleksändring ger bättre flexibilitet för optimal prestanda
- Stödjer UFS ver. 4.1-standarden
- Minskad pakethöjd för 1 TB-modellen jämfört med föregående generation⁽⁴⁾
- Använder KIOXIAs 8:e generationens BiCS FLASH™ 3D flashminne⁽¹⁾

"KIOXIAs nya UFS ver. 4.1 för inbyggda minnesenheter innebär ett betydande framsteg och stärker KIOXIAs ledarskap inom högpresterande lagring och dess åtagande att leda innovationen inom flashlagring", säger Axel Störmann, Vice President och Chief Technology Officer för minnes- och SSD-produkter, KIOXIA Europe GmbH. "Dessa enheter är konstruerade med 8:e generationens BiCS FLASH™- och CBA-teknik och uppfyller kraven för morgondagens mobila applikationer av nästa generation, inklusive inbyggd AI, vilket innebär ett enormt steg framåt jämfört med föregångarna."

###

Fotnoter:

(1) Endast för modellerna 512 GB / 1 TB.

(2) Universal Flash Storage (UFS) är en produktkategori för en klass inbäddade minnesprodukter byggda enligt standardspecifikationen JEDEC UFS. Tack vare sitt seriella gränssnitt stödjer UFS fullständig duplex som möjliggör samtidig läsning och skrivning mellan värdprocessorn och UFS-minnet.

(3) Jämfört med föregående generationens 512GB-enhet "THGJFMT2E46BATV" respektive 1TB-enhet "THGJFMT3E86BATZ" (endast 512 GB-/1 TB-modeller).

(4) Den föregående generationens 1TB-enhet "THGJFMT3E86BATZ".

*I varje omnämnande av en KIOXIA-produkt: Produkttäthet identifieras utifrån tätheten av minneschip i produkten, inte mängden minneskapacitet som är tillgänglig för datalagring hos slutanvändaren. Kapaciteten som kan användas av konsumenter är lägre på grund av overheaddataområden, formatering, dåliga block och andra begränsningar, och kan också variera beroende på värdenhet och applikation. Mer information finns i de tillämpliga produktspecifikationerna. Definitionen av 1 KB = 2^{10} byte = 1 024 byte. Definitionen av 1 Gb = 2^{30} bitar = 1 073 741 824 bitar. Definitionen av 1 GB = 2^{30} byte = 1 073 741 824 byte. 1 Tb = 2^{40} bitar = 1 099 511 627 776 bitar. 1 TB = 2^{40} byte = 1 099 511 627 776 byte.

*Läs- och skrivhastigheter är de bästa värdena uppnådda i en specifik testmiljö hos KIOXIA Corporation, och KIOXIA Corporation garanterar varken läs- eller skrivhastigheter i enskilda enheter. Läs- och skrivhastigheten kan variera beroende på vilken enhet som används och vilken filstorlek som läses eller skrivs.

*Företagsnamn, produktnamn och namn på tjänster kan vara varumärken som tillhör tredjepartsföretag.

*Följande varumärken, tjänste- och/eller företagsnamn – JEDEC, JEDEC Solid State Technology Association – tillämpas inte, registreras inte, skapas inte och/eller ägs inte av KIOXIA Europe GmbH eller av anslutna företag inom KIOXIA-koncernen. De kan dock tillämpas, registreras, skapas och/eller ägas av tredje part i olika jurisdiktioner och är därför skyddade mot obehörig användning. Alla andra företagsnamn, produktnamn och namn på tjänster kan vara varumärken som tillhör tredjepartsföretag.

Om KIOXIA Europe GmbH

KIOXIA Europe GmbH (tidigare Toshiba Memory Europe GmbH) är det Europabaserade dotterbolaget till KIOXIA Corporation, en världsledande leverantör av flashminne och SSD-enheter. Från uppfinnandet av NAND-flashminnen till dagens banbrytande BiCS FLASH™ har KIOXIA fortsatt att gå i bräschen för innovativa minneslösningar och tjänster som berikar människors liv och expanderar samhällets horisonter. Företagets innovativa flashminnesteknik BiCS FLASH™ 3D sätter standarden för framtidens lagring i tillämpningar med hög densitet, exempelvis avancerade smarttelefoner, datorer, SSD-enheter, bilar och datacenter.

Besök [KIOXIAs webbplats](#)

Kontaktuppgifter för publicering:

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Tyskland

Tel: +49 (0)211 368 77-0

E-post: KIE-support@kioxia.com

Kontaktuppgifter för redaktionella förfrågningar:

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tel: +49 (0) 211 36877 382

E-post: lena1.hoffmann@kioxia.com

Publicerat av:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel.: +49 (0)4181 968098-13

E-post: birgit.schoeniger@publitek.com

Webb: www.publitek.com